

10/511423

Rec'd PCT/PTO 15 OCT 2004

1/4

特許協力条約に基づく国際出願願書

原本（出願用） - 印刷日時 2003年04月12日（12. 04. 2003）土曜日 17時57分21秒

pf-3167

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/R0/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書は、 右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.92 (updated 01.01.2003)
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。	
0-8	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (R0/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	pf-3167
I	発明の名称	半導体装置およびその製造方法
II	出願人 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である。	出願人である (applicant only) 米国を除くすべての指定国 (all designated States except US)
II-4)a	名称	日本電気株式会社
II-4en	Name	NEC Corporation
II-5)a	あて名:	108-8001 日本国 東京都 港区 芝五丁目7番1号
II-6en	Address:	7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001 Japan
II-6	国籍 (国名)	日本国 JP
II-7	住所 (国名)	日本国 JP
III-1	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-1-1	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-1-4)	氏名 (姓名)	渡部 平司
III-1-4e	Name (LAST, First)	WATANABE, Heiji
III-1-5)	あて名:	108-8001 日本国 東京都 港区 芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内
III-1-5e	Address:	c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001 Japan
III-1-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-1-7	住所 (国名)	日本国 JP

NEC 03/0468

